



„EUROELEKTRA”

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Rok szkolny 2013/2014

**Zadania z elektroniki na zawody II stopnia  
(grupa elektroniczna)**

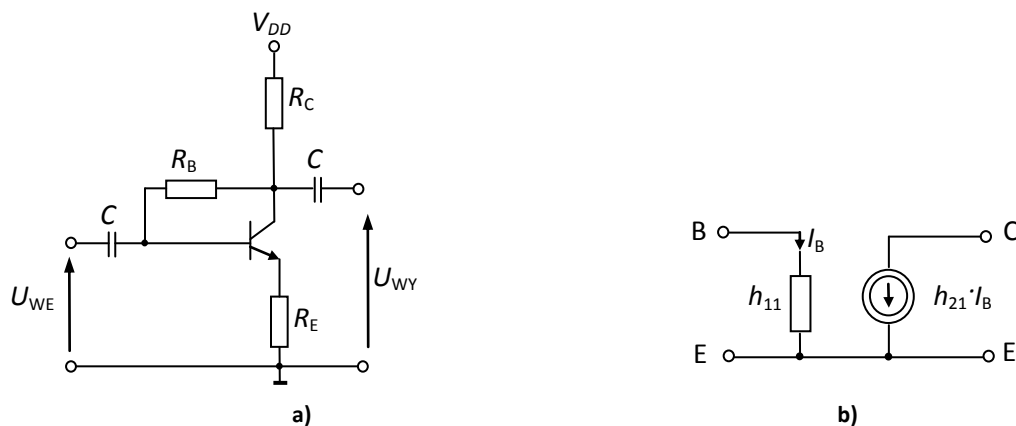
**Zadanie 1.**

Oblicz rezystancję wejściową  $R_{we}$  wzmacniacza przedstawionego na rysunku 1a. Określ wpływ na wartość tej rezystancji: napięciowego równoległego ujemnego sprzężenia zwrotnego wprowadzonego przez rezystancję  $R_B$  oraz prądowego szeregowego ujemnego sprzężenia zwrotnego wprowadzonego przez rezystancję  $R_E$ .

**Dane:** Parametry hybrydowe tranzystora w układzie OE wynoszą:  $h_{11e}=1\text{ k}\Omega$ ,  $h_{12e}=0$ ,  $h_{21e}=50$ ,  $h_{22e}=0$ . Wartości rezystancji są następujące:  $R_B=220\text{ k}\Omega$ ,  $R_C=5\text{ k}\Omega$ ,  $R_E=50\Omega$ . Dla częstotliwości sygnału przyjąć, że  $X_C \approx 0$ .

Do wyliczeń można posłużyć się uproszczonym modelem małosygnalowym tranzystora pracującego w układzie OE pokazanym na rysunku 1b.

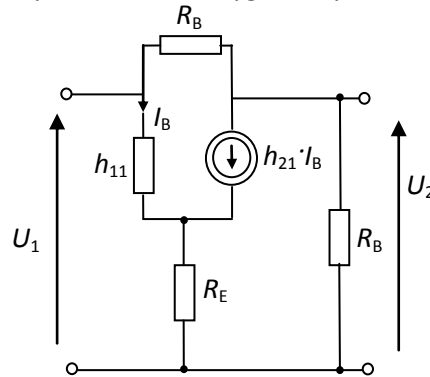
**Uwaga:** Porównaj uzyskane wyniki  $R_{we}$  dla 4 przypadków, tj. wzmacniacza z ( $R_B=220\text{ k}\Omega$ ,  $R_E=50\Omega$ ), wzmacniacza bez sprzężeń zwrotnych ( $R_B=\infty$ ,  $R_E=0$ ), dla wzmacniacza tylko z napięciowym równoległym sprzężeniem zwrotnym ( $R_B=220\text{ k}\Omega$ ,  $R_E=0$ ) i wzmacniacza tylko z prądowym szeregowym sprzężeniem zwrotnym ( $R_B=\infty$ ,  $R_E=50\Omega$ ).



Rysunek 1. Schemat układu do zadania 1

## Odpowiedź:

W celu obliczenia danych narysujemy schemat małosygnalowy układu.



Rezystancja wejściowa wzmacniacza równa jest:

$$R_{we} = \frac{(R_B + R_C)[h_{11} + (1 + h_{21})R_E]}{h_{11} + (1 + h_{21})(R_C + R_E) + R_B} = 1669\Omega$$

Rezystancja wejściowa wzmacniacza bez sprzężeń zwrotnych, tj. dla  $R_B = \infty$  i  $R_E = 0$  wynosi:

$$R_{we} = h_{11} = 1k\Omega$$

dla  $R_E = 0$  i  $R_B \neq 0$

$$R_{we} = h_{11} \frac{(R_B + R_C)}{h_{11} + R_C(1 + h_{21}) + R_B} = 470\Omega$$

Sprzężenie zwrotne napięciowe równoległe zmniejsza rezystancję wejściową wzmacniacza.

dla  $R_E \neq 0$  i  $R_B = \infty$ , po przekształceniach

$$R_{we} = \frac{\left(1 + \frac{R_C}{R_B}\right)[h_{11} + (1 + h_{21})R_E]}{\frac{h_{11}}{R_B} + (1 + h_{21})\left(\frac{R_C + R_E}{R_B}\right) + 1} \Big|_{dla R_B = \infty} = h_{11} + (1 + h_{21})R_E = 3550\Omega$$

Sprzężenie zwrotne prądowo szeregowo zwiększa rezystancję wejściową wzmacniacza.

## Zadanie 2.

Termistor jest rezystorem półprzewodnikowym, którego rezystancja zależy od temperatury zgodnie z poniższą zależnością:

$$R(T) = R_0 \cdot e^{\frac{W_g}{2 \cdot k \cdot T}} [\Omega],$$

gdzie:  $R_0$  – stała termistora  $[\Omega]$ ,

$W_g$  – szerokość pasma przerwy zabronionej materiału, z którego wykonany jest termistor [eV],

$k = 8,617 \cdot 10^{-5}$  [eV/K] – stała Boltzmana,

$T$  – temperatura termistora [K].

Dysponując następującymi danymi:  $R = 100 \Omega$  w temperaturze  $27^\circ\text{C}$ , szerokość pasma przerwy zabronionej  $W_g = 1,43$  eV, wykonaj następujące polecenia:

- wyznacz stałą termistora  $R_0$ ,
- wyznacz współrzędne, co najmniej pięciu punktów charakterystyki rezystancji w funkcji temperatury  $R = f(T)$  tego termistora oraz sporządź jej wykres,
- wyprowadź wzór opisujący czułość temperaturową termistora  $S_T = \frac{\partial R(T)}{\partial T} \left[ \frac{\Omega}{\text{K}} \right]$ ,
- określ materiał z jakiego jest on wykonany, a odpowiedź uzasadnij.

### Odpowiedź:

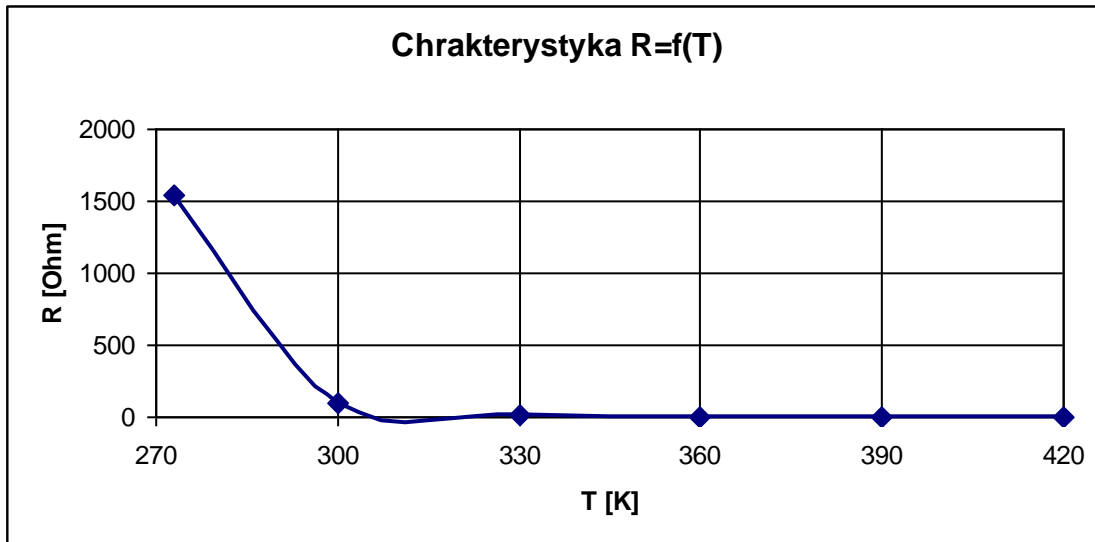
Dysponując następującymi danymi:  $R = 100 \Omega$  w temperaturze  $27^\circ\text{C}$ , szerokość pasma przerwy zabronionej  $W_g = 1,43$  eV, wykonaj następujące polecenia:

- wyznacz stałą termistora  $R_0$

$$R_0 = \frac{R}{e^{\frac{W_g}{2kT}}} = \frac{100}{e^{\frac{1,43}{2 \cdot 8,617 \cdot 10^{-5} \cdot 300}}} = 9,73 \cdot 10^{-11} [\Omega]$$

- wyznacz współrzędne, co najmniej pięciu punktów charakterystyki rezystancji w funkcji temperatury  $R = f(T)$  tego termistora oraz sporządź jej wykres,

$T[\text{K}]$	273	300	330	360	390	420
$R[\Omega]$	1541,68	100,00	8,01	1,00	0,17	0,04



c) wyprowadź wzór opisujący czułość temperaturową termistora  $S_T = \frac{\partial R(T)}{\partial T} \left[ \frac{\Omega}{K} \right]$

$$S_T = \frac{\partial R(T)}{\partial T} = -\frac{R_0 \cdot W_g}{2 \cdot k \cdot T^2} \cdot e^{\frac{W_g}{2 \cdot k \cdot T}} \left[ \frac{\Omega}{K} \right]$$

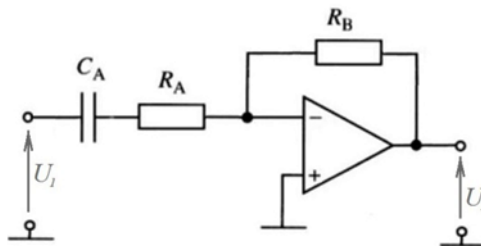
d) określ materiał z jakiego jest on wykonany, a odpowiedź uzasadnij

Termistor jest wykonany z GaAs (arsenku galu), ponieważ szerokość pasma przerwy zabronionej  $W_g$  wynosi 1,43 eV.

### Zadanie 3.

Dla układu różniczkującego przedstawionego na rysunku 2, który zbudowano na idealnym wzmacniaczu operacyjnym wyznaczyć transmitancję napięciową oraz obliczyć moduł wzmocnienia  $K_u$  i przesunięcie fazy  $\varphi_u$  dla częstotliwości  $f=1\text{kHz}$  i  $10\text{kHz}$  (sygnał sinusoidalny).

**Dane:**  $R_A=10\text{ k}\Omega$ ,  $R_B=100\text{ k}\Omega$ ,  $C_A=10\text{ nF}$



Rysunek 2. Schemat układu do zadania 3

### Odpowiedź:

Wzmacniacz jest idealny więc prąd wejścia jest równy prądowi płynącemu przez  $R_B$  oraz napięcie w węźle (-) wynosi 0V, stąd  $I_1=U_1/Z_1$  ( $Z_1=R_A+1/j\omega C_A$ ),  $I_2=-U_2/R_B$

z równości  $I_1=I_2$  wynika, że  $U_2/U_1=-R_B/Z_1$ , po podstawieniu  $Z_1$  i uporządkowaniu równania trzymamy

$$U_2/U_1 = \frac{j\omega R_B C_A}{1+j\omega R_A C_A} \quad \text{wygodnie jest podstawić } \omega_1=1/R_A C_A, \quad \omega_2=1/R_B C_A,$$

Wtedy  $\frac{U_2}{U_1} = -\frac{j\omega/\omega_2}{1+j\omega/\omega_1}$  po pomnożeniu licznika i mianownika przez  $(1-j\omega/\omega_1)$  otrzymamy wyrażenie

$$\frac{U_2}{U_1} = -\frac{\frac{\omega^2}{\omega_1\omega_2} + j\frac{\omega}{\omega_2}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}$$

Moduł wzmacnienia  $\left|\frac{U_2}{U_1}\right| = \frac{\frac{\omega}{\omega_2}}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2} \sqrt{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2}$  a przesunięcie fazy  $\varphi = \arctg(\omega_1/\omega)$

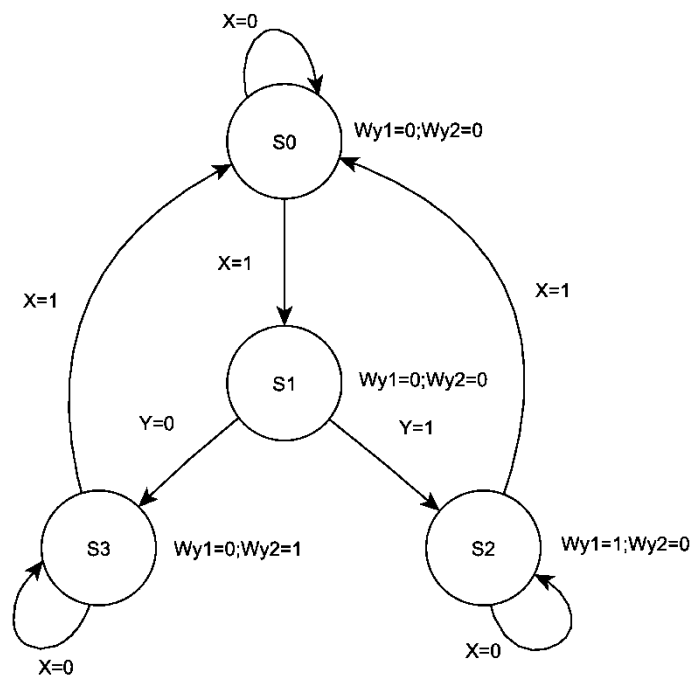
Wyniki obliczeń:

Dla 1kHz  $\left|\frac{U_2}{U_1}\right| = 5,319 \quad \varphi = 57,86 \text{ } (\varphi = -122)$

Dla 10kHz  $\left|\frac{U_2}{U_1}\right| = 9,876 \quad \varphi = 9,04 \text{ } (\varphi = -171)$

#### Zadanie 4.

Zaprojektuj z wykorzystaniem przerzutników D automat Moore'a zgodnie z grafem przedstawionym na rysunku 3. Na rysunku X,Y są to wejścia automatu, natomiast Wy1,Wy2 są to wyjścia automatu.



Rysunek 3. Graf stanów automatu do zadania 4

**Odpowiedź:**

Wyjścia:

Stan	wyjścia	
	Wy1	Wy2
S0	0	0
S1	0	0
S3	0	1
S2	1	0

Stan obecny		Następny Stan Q0Q1				Wyjścia	
Stan	q0q1	00	01	11	10	Wy1	Wy2
S0	00	00	01	01	00	0	0
S1	01	11	11	10	10	0	0
S3	11	11	00	00	11	0	1
S2	10	10	00	00	10	1	0

Dla Q0

YX \ q0q1	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$Q0 = \overline{q0}q1 + q0\overline{x}$$

Dla Q1

YX q0q1	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	0	0
11	1	0	0	1
10	0	0	0	0

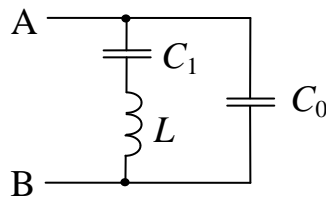
$$Q1 = \overline{q0q1} x + \overline{q0} q1 \bar{y} + q0 q1 \bar{x}$$

$$Wy2 = q0 q1$$

$$Wy1 = q0 \overline{q1}$$

#### Zadanie 5.

Na rysunku 4 pokazany jest uproszczony schemat elektryczny bezstratnego rezonatora kwarcowego. Wykorzystując użyte zmienne  $C_1$ ,  $C_0$  i  $L$  wyznacz przedział częstotliwości, w którym impedancja widziana z pary zacisków AB, tj.  $Z_{AB}$ , ma charakter indukcyjny oraz przedział, w którym impedancja ta ma charakter pojemnościowy.



Rysunek 4. Schemat układu do zadania 5

#### Odpowiedź:

W dziedzinie zmiennej zespolonej  $s$  impedancja widziana z zacisków AB określona jest wzorem

$$Z_{AB} = \frac{1}{sC_0 + \frac{1}{sL + \frac{1}{sC_1}}} = \frac{1}{sC_0 + \frac{sC_1}{s^2C_1L + 1}} = \frac{s^2C_1L + 1}{sC_0(s^2C_1L + 1 + \frac{C_1}{C_0})} = \frac{1}{sC_0} \left\{ \frac{s^2 + \frac{1}{LC_1}}{s^2 + \frac{1}{L} \left( \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_0} \right)} \right\} = \frac{1}{sC_0} \left\{ \frac{s^2 + \omega_L^2}{s^2 + \omega_M^2} \right\}$$

W podanym wzorze współczynnik  $\omega_M$  jest większy od  $\omega_L$ , co wynika z nierówności

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_0} > \frac{1}{C_1}$$

oraz wyrażeń opisujących te współczynniki w pokazanym wyżej równaniu.

Dokonując podstawienia  $s=j\omega$ , tzn. przechodząc do metody symbolicznej, podany wzór na impedancję  $Z_{AB}$  przyjmuje postać

$$Z_{AB} = \frac{-j}{\omega C_0} \left\{ \frac{-\omega^2 + \omega_L^2}{-\omega^2 + \omega_M^2} \right\} = jX_{AB}$$

Impedancja  $Z_{AB}$  ma charakter pojemnościowy, gdy jej moduł ( $X_{AB}$ ) jest ujemny. Jest tak wtedy, gdy pulsacja  $\omega$  jest mniejsza od  $\omega_L$  lub, gdy jest większa od  $\omega_M$ . Pierwszy przypadek oznacza spełnienie nierówności

$$\omega < \omega_L < \omega_M,$$

a drugi nierówności

$$\omega_L < \omega_M < \omega$$

Impedancja  $Z_{AB}$  ma charakter indukcyjny ( $X_{AB}$  przyjmuje wartości dodatnie), gdy pulsacja  $\omega$  mieści się między  $\omega_L$ , a  $\omega_M$ , tzn., gdy

$$\omega_L < \omega < \omega_M$$

***Opracował:***

dr hab. inż. Ryszard Wojtyna, prof. UTP  
 dr inż. Łukasz Saganowski  
 dr inż. Stefan Stróżecki  
 dr inż. Tomasz Talaśka  
 dr inż. Sławomir Andrzej Torbus

***Sprawdził:***

dr inż. Tomasz Talaśka

***Zatwierdził:***

dr hab. inż. Sławomir Cieślik  
*Przewodniczący*  
*Rady Naukowej Olimpiady*